



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(СПбГУ)

Университетская наб., 7/9, Санкт-Петербург, 199034  
тел./ факс 328-97-88  
http://www.spbu.ru  
ОКПО 02068516 ОГРН 1037800006089  
ИНН/КПП 7801002274/780101001

23.06.2022 № 01/1-35-818

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О согласии

ФГАОУ ВО «Санкт-  
Петербургский государственный  
электротехнический университет  
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова  
(Ленина)»  
Минобрнауки России

Председателю  
диссертационного совета  
Д212.238.04

Лучинину В.В.

Уважаемый Виктор Викторович!

В ответ на Ваше обращение (исх. от 16.06.2022 № 0086/с-190) подтверждаю согласие Санкт-Петербургского государственного университета выступить ведущей организацией по диссертации Комкова Олега Сергеевича на тему: «Фотомодуляционная оптическая спектроскопия полупроводниковых материалов и кваново-размерных структур», представленной к защите на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.10 – Физика полупроводников, и направляю сведения о Санкт-Петербургском государственном университете как ведущей организации, а также сведения о лице, утверждающем отзыв ведущей организации на данную диссертацию.

- Приложение: 1. Сведения о ведущей организации — на 3 л. в 1 экз.  
2. Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации — на 1 л. в 1 экз.

Директор Центра экспертиз

*А.В. Попов*

А.В. Попов

Исполнитель:  
И.П.Ковалева,  
Тел.: (812) 327-46-15

### Сведения о ведущей организации

по докторской диссертации Комкова Олега Сергеевича «Фотомодуляционная оптическая спектроскопия полупроводниковых материалов и кваново-размерных структур», по специальности 01.04.10 – Физика полупроводников

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом	Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский университет или СПбГУ
Ведомственная принадлежность	Правительство Российской Федерации
Почтовый индекс, адрес организации	199034, Санкт-Петербург, Университетская наб. д.7/9
Адрес официального сайта в сети «Интернет»	www.spbu.ru
Телефон	+7 (812) 328-97-01
Адрес электронной почты	spbu@spbu.ru
Список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Danilov, D., Vyvenko, O., Loshachenko, A., Sobolev, N. Electron Emission from the Electronic States of Oxygen Precipitates in Oxygen-Implanted Silicon (2022) Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, 219 (7), статья № 2100662.</li> <li>2. Shapenkov, S., Vyvenko, O., Ubyivovk, E., Mikhailovskii, V. Fine core structure and spectral luminescence features of freshly introduced dislocations in Fe-doped GaN (2022) Journal of Applied Physics, 131 (12), статья № 125707.</li> <li>3. Shapenkov, S., Vyvenko, O., Nikolaev, V., Stepanov, S., Pechnikov, A., Scheglov, M., Varygin, G. Polymorphism and Faceting in Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Layers Grown by HVPE at Various Gallium-to-Oxygen Ratios (2022) Physica Status Solidi (B) Basic Research, 259 (2), статья № 2100331.</li> <li>4. Shapenkov, S.V., Vyvenko, O.F., Schmidt, G.,</li> </ol>

Bertram, F., Metzner, S., Veit, P., Christen, J. Characteristic emission from quantum dot-like intersection nodes of dislocations in GaN (2021) Journal of Physics: Conference Series, 1851 (1), статья № 012013.

5. Shapenkov, S., Vyvenko, O., Ubyivovk, E., Medvedev, O., Varygin, G., Chikiryaka, A., Pechnikov, A., Scheglov, M., Stepanov, S., Nikolaev, V. Halide Vapor Phase Epitaxy  $\alpha$ - and  $\epsilon$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Epitaxial Films Grown on Patterned Sapphire Substrates (2020) Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, 217 (14), статья № 1900892.
6. Nikolaev, V.I., Stepanov, S.I., Pechnikov, A.I., Shapenkov, S.V., Scheglov, M.P., Chikiryaka, A.V., Vyvenko, O.F. HVPE Growth and Characterization of  $\epsilon$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Films on Various Substrates (2020) ECS Journal of Solid State Science and Technology, 9 (4), статья № 045014.
7. Danilov, D., Vyvenko, O., Loshachenko, A., Sobolev, N. Peculiarity of Electric Properties of Oxygen-Implanted Silicon at Early Precipitation Stages (2019) Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, 216 (17), статья № 1900327.
8. Medvedev, O., Albrecht, M., Vyvenko, O. Unusual Polarization Dependence of Dislocation-Related Luminescence in n-GaN (2019) Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, 216 (17), статья № 1900305.
9. Medvedev, O., Albrecht, M., Vyvenko, O. Asymmetry of the Atomic Core Structure of Dissociated a-Screw Dislocation in GaN Probed by Polarization Optical Spectroscopy (2019) Physica Status Solidi - Rapid Research Letters, 13 (9), статья № 1900169.
10. Trushin, M., Varlamov, A., Loshachenko, A., Vyvenko, O., Kittler, M. Combined DLTS/MCTS investigations of deep electrical levels of regular dislocation networks in silicon (2019) Journal of Physics: Conference Series, 1190 (1), статья № 012005.

	<p>11. Vyvenko, O., Bondarenko, A. Crystal lattice defects as natural light emitting nanostructures in semiconductors (2019) Springer Series in Chemical Physics, 119, pp. 405-436.</p> <p>12. Bondarenko, A., Vyvenko, O. Band-Like Behavior of Localized States of Metal Silicide Precipitate in Silicon (2018) Journal of Electronic Materials, 47 (9), pp. 4975-4979.</p> <p>13. Petrov, Y.V., Anikeva, A.E., Vyvenko, O.F. Helium ion beam induced electron emission from insulating silicon nitride films under charging conditions (2018) Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 425, pp. 11-17.</p> <p>14. Medvedev, O., Vyvenko, O., Ubyivovk, E., Shapenkov, S., Bondarenko, A., Saring, P., Seibt, M. Intrinsic luminescence and core structure of freshly introduced a-screw dislocations in n-GaN (2018) Journal of Applied Physics, 123 (16), статья № 161427.</p> <p>15. Maksimova, K.Y., Kozlov, A.A., Shvets, P.V., Koneva, U.Y., Yurkevich, O.V., Lebedev, O.I., Vyvenko, O.F., Mikhailovskii, V.Y., Goikhman, A.Y. Copper-Stabilized Si/Au Nanowhiskers for Advanced Nanoelectronic Applications (2018) ACS Omega, 3 (2), pp. 1684-1688.</p>
--	--

Верно

Директор Центра экспертиз



А.В. Попов

**Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации**

Фамилия, имя, отчество	Микушев Сергей Владимирович
Ученая степень и отрасль науки, научные специальности, по которым им защищена диссертация	Кандидат физико-математических наук 01.04.07 – физика конденсированного состояния Физико-математические науки
Наименование организации, являющееся основным местом работы, должность	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» Правительства Российской Федерации. Проректор по научной работе.

Верно

Директор Центра экспертиз



А.В. Попов